

دانشگاه پیام نور

گروه فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک حالت جامد

عنوان پایان نامه

بررسی خواص نوری - مغناطیسی لایه های نازک اکسیدهای دوتایی

منگنز - کبالت

استاد راهنما

دکتر ابراهیم عطاران کاخکی

استاد مشاور

دکتر جمیل آریایی

نگارش

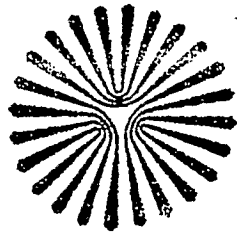
مهدي عادلې فرد

شهریور ۱۳۸۶

دفتر اطلاع رسانی و تبلیغات
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸

۸۸۸۸۸۸۸۸ / ۰۲۱

۱۵۱۳۳۹



دانشگاه پیام نور

بسمه تعالی

تصویب نامه پایان نامه

پایان نامه تحت عنوان: بررسی خرد فلسفی نوری عوفی هلی لایه های نازک منگنز و کبالت
که توسط آقای علی فرزاد تهیه و به هیئت داوران ارائه گردیده است مورد تأیید می باشد.

تاریخ دفاع: ۱۳۹۶/۶/۲۵ نمره: ۱۹٫۸۵ و نهم درجه ارزشیابی: عالی
اعضای هیئت داوران:

نام و نام خانوادگی	هیئت داوران	مرتبۀ علمی	امضاء
دکتر ابراهیم عطاریان	استاد راهنما	استاد ارشد	
مهندس آرمان	استاد راهنمای همکار	استاد ارشد	
مهندس آرمان	استاد مشاور	استاد ارشد	
دکتر سعید محمدی	استاد ممتحن	نماینده گروه امور آموزشی	

استاد ارشد

استاد راهنما

استاد راهنمای همکار

استاد مشاور

استاد ممتحن

نماینده گروه امور آموزشی

مهندس آرمان
دکتر سعید محمدی

- ۱- امضاءات
- ۲- تصدیقات تکمیلی
- ۳- پرونده دانشجو
- ۴- دانشجو

با عنایت پروردگار، مدت‌ها تلاش و بهره‌گیری از محضر استادان گرانقدر که همواره راهنمای من در عرصه علم و ادب بودند این کار به پایان رسید و امروز بر خویش فرض می‌دانم که سپاسگذار زحمات بزرگوارانی باشم که بی‌هیچ تردیدی روشن‌کننده این راه بودند.

در ابتدا خود را مرهون محبت و راهنمایی بی‌دریغ جناب آقای دکتر عطاران می‌دانم که در این مدت همواره مشوق بنده بودند و با فرصت‌هایی که در اختیار من قرار دادند، مراتب پیشبرد کار را مهیا نمودند، جا دارد مراتب قدرشناسی و سپاس خود را به محضر این استاد عزیز نثار نمایم.

همچنین از استادان ارجمند جناب آقای دکتر آریایی، مشاور این پایان‌نامه و جناب آقای دکتر شاه‌طهماسبی، استاد محترم گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد که بر من منت نهادند و با شرکت در جلسه دفاعیه ایرادات کار را در نهایت دقت و ظرافت بررسی و گوشزد نمودند و مرا در رفع این اشکالات یاری فرمودند، بی‌نهایت سپاسگزارم.

در خاتمه از جناب آقای محقق‌ی که در طول این دوره، همواره لطف ایشان شامل حال من بود، بسیار متشکرم. بار دیگر درود و سپاس خود را به محضر همه استادان محترم تقدیم نموده و از خداوند منان برای همه این عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق خدمت‌آرزومندم.

با سپاس فراوان

مهدی عادل‌ی فرد - شهریور ۱۳۸۶

فهرست مطالب

صفحه	عناوین
۱	۱ مقدمه ای بر آثار نوری - مغناطیسی مواد
۲	۱-۱ پیشگفتار
۴	۲-۱ آثار نوری - مغناطیسی مواد
۴	۱-۲-۱ اثر فارادی
۶	۲-۲-۱ اثر کر
۷	۳-۲-۱ اثرهای کرو فارادی در مواد غیر فرو مغناطیس
۷	۳-۱ کاربردهای اثر نوری - مغناطیسی
۷	۱-۳-۱ مجزا کننده اپتیکی
۸	۲-۳-۱ ذخیره سازی نوری - مغناطیسی
۸	۳-۳-۱ آشکار سازی مغناطش در اشیاء بسیار کوچک و رسم حلقه پسماند
۹	۴-۱ حالات مختلف قطبش و تابش
۹	۱-۴-۱ حالت قطبی
۱۰	۲-۴-۱ حالت طولی
۱۰	۳-۴-۱ حالت عرضی
۱۱	۵-۱ تاریخچه تحقیقات
۱۲	۶-۱ منابع
۱۳	۲ مبانی نظری رفتار نوری - مغناطیسی
۱۴	۱-۲ پیشگفتار
۱۶	۲-۲ نظریه کلاسیک رفتار نوری - مغناطیسی
۱۸	۳-۲ نظریه کوانتومی رفتار نوری - مغناطیسی
۲۸	۴-۲ منابع
۲۹	۳ اثرات فیزیکی مربوط به ذخیره سازی نوری مغناطیسی اطلاعات
۳۰	۱-۳ نور قطبیده
۳۲	۱-۱-۳ اثر کر قطبی
۳۴	۲-۱-۳ مغناطش دایروی دو شکستی
۳۶	۲-۳ دسته بندی مواد مغناطیسی

۳۸	۱-۲-۳ مواد فرو مغناطیس
۳۹	۱-۱-۲-۳ مغناطش خودبه خودی و مغناطش در میدان
۴۴	۲-۱-۲-۳ حساسیت مغناطش به دما
۴۵	۳-۱-۲-۳ مغناطش اشباع
۴۵	۴-۱-۲-۳ منحنی پسماند
۴۶	۲-۲-۳ مواد آنتی فرو مغناطیس
۴۷	۳-۳ ناهمسانگردی مغناطیسی
۴۸	۱-۳-۳ ناهمسانگردی بلوری
۴۹	۲-۳-۳ ناهمسانگردی تنشی
۵۰	۴-۳ قانون مالوس
۵۱	۵-۳ منابع
۵۲ ۴ لایه های نازک
۵۳	۱-۴ پیشگفتار
۵۴	۲-۴ روش های مختلف تهیه لایه های نازک مغناطیسی
۵۵	۳-۴ اکسیدهای نوع اسپینل فلزی
۵۵	۱-۳-۴ اکسید کبالت
۵۷	۲-۳-۴ لایه های نازک $Mn_xCo_{3-x}O_4$ ($0 \leq x \leq 1$)
۵۹	۴-۴ روش اسپری پایرولیزیز
۵۹	۵-۴ مکانیسم تشکیل لایه نازک به روش اسپری پایرولیزیز
۶۰	۶-۴ تهیه وساخت لایه های نازک منگنز و کبالت
۶۲	۱-۶-۴ لایه نازک خالص اکسید کبالت
۶۳	۲-۶-۴ لایه نازک خالص اکسید منگنز
۶۴	۳-۶-۴ دو لایه ای اکسید کبالت / اکسید منگنز
۶۵	۴-۶-۴ دو لایه ای اکسید منگنز / اکسید کبالت
۶۶	۵-۶-۴ لایه های ترکیبی منگنز و کبالت
۶۸	۷-۴ منابع
۷۰ ۵ روش های اندازه گیری
۷۱	۱-۵ سامانه اندازه گیری اثر کروفارادی
۷۲	۱-۱-۵ معرفی و کاربرد هر یک از اجزاء سامانه

۷۲	۱-۱-۱-۵ لیزر هلیم- نئون
۷۲	۲-۱-۱-۵ فتوسل مینا
۷۴	۳-۱-۱-۵ تیغه شیشه ای
۷۴	۴-۱-۱-۵ قطبشگرها
۷۴	۵-۱-۱-۵ تقویت کننده
۷۵	۶-۱-۱-۵ کارت I/O
۷۶	۷-۱-۱-۵ مقاومت های سری شده با آهن ربای الکتریکی
۷۷	۲-۱-۵ شرح آزمایش
۷۹	۲-۵ اندازه گیری های اپتیکی برای تعیین ضریب شکست و ضخامت لایه های نازک یکنواخت با روش سان پل
۸۲	۳-۵ اندازه گیری گاف انرژی لایه های نازک منگنزوکبالت
۸۴	۴-۵ منابع

۸۵ **۶ بحث و نتیجه گیری**

۸۶	۱-۶ مطالعه اثر فارادی در لایه های منگنزوکبالت
۸۶	۱-۱-۶ اندازه گیری و رسم نمودارها
۸۹	۲-۶ مطالعه اثر کر در لایه های نازک منگنزوکبالت
۸۹	۱-۲-۶ اندازه گیری و رسم نمودارها
۹۲	۳-۶ مطالعه خواص اپتیکی
۹۲	۱-۳-۶ اندازه گیری ضریب شکست و ضخامت لایه ها
۹۳	۲-۳-۶ تعیین گاف انرژی
۹۳	۲-۳-۶ الف لایه اکسید کبالت
۹۴	۲-۳-۶ ب لایه $Mn_{0.25}Co_{2.75}O_4$
۹۶	۲-۳-۶ ج لایه $Mn_{0.5}Co_{2.5}O_4$
۹۷	۲-۳-۶ د دو لایه ای Co_3O_4/MnO
۹۸	۲-۳-۶ ه دو لایه ای MnO/Co_3O_4
۹۹	۴-۶ جمع بندی از نتایج به دست آمده
۱۰۰	۵-۶ منابع

پیوست الف

پیوست ب

فصل اول

مقدمه ای بر آثار نوری مغناطیسی مواد

- ۱-۱ پیشگفتار
- ۲-۱ آثار نوری - مغناطیسی مواد
- ۳-۱ کاربردهای اثر نوری - مغناطیسی
- ۴-۱ حالات مختلف قطبش و تابش
- ۵-۱ تاریخچه‌ی تحقیقات
- ۶-۱ منابع

۱-۱ پیشگفتار

پیشرفت و توسعه وسایل ذخیره سازی داده ها با ظرفیت ثبت زیاد، به صورت یک موضوع کلیدی در فن آوری محسوب می شود.

علاوه بر این ذخیره ی حجم عظیم اطلاعات و بازخوانی مجدد آنها امری است که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. کشف لیزر و ساخت رشته های باریک شیشه ای (فیبرنوری)، دریچه ای جدید را برای انتقال سریع داده ها گشوده است.

نشان دادن اطلاعات دیجیتالی به صورت صفر و یک توسط باریکه ای از لیزر، اساس انتقال اطلاعات بوسیله ی لیزراست و برای این کار به ابزاری به نام مدوله ساز نیاز است که بتواند در سرعت های بالا و به شیوه ای نظام یافته، تغییری در موج ایجاد کند. این تغییر می تواند چرخش راستای قطبش نور لیزر باشد. به بیان ساده تر می توان یک راستای مشخص قطبیدگی را به عنوان صفر و راستای دیگر را به عنوان یک در نظر گرفت تا در آنسوی فیبر نوری بوسیله ی یک صفحه ی قطبشگر این صفر و یک ها از هم جدا شوند.

آنچه قبلا مرسوم بوده، ثبت اطلاعات بر روی صفحات مغناطیسی از قبیل نوارها و دیسک ها به صورت ضبط طولی^۱ بوده است. در این روش بسیاری از مشکلات ذاتی از قبیل ناپایداری دمای تولید شده به وسیله هد مغناطیسی، چگالی ثبت را محدود می کند [۱].

یک روش برای افزایش چگالی ثبت، ضبط عمودی^۲ داده ها نسبت به ضبط طولی بر روی وسیله مورد نظر می باشد.

خصوصیت فیزیکی مربوطه موسوم به اثر ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی^۳ (PMA) می باشد. طرحی از اصول مربوط به ثبت مغناطیسی-نوری عمودی^۴ در شکل ۱ آمده است.

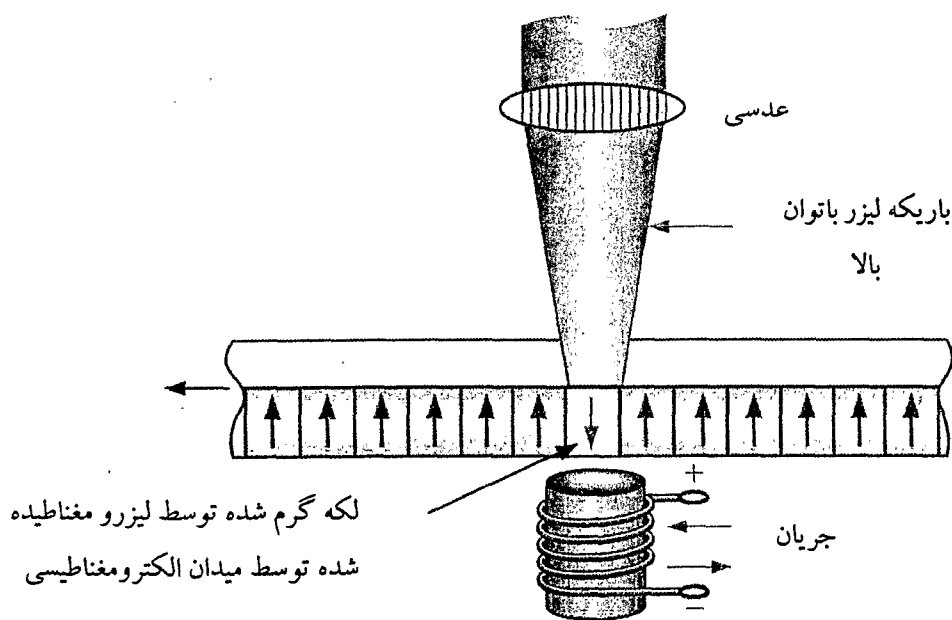
۱- Longitudinal case

۲-Polar case

برخلاف سیستم های ضبط مغناطیسی تجاری که برای خواندن داده، با ایجاد شار مغناطیسی متغیر روی سطح دیسک در هدهای مغناطیسی جریان هایی القا می کند، سیستم های نوری مغناطیسی (MO) از نور قطبیده برای خواندن داده از روی دیسک استفاده می کنند. در حضور یک میدان مغناطیسی روی سطح دیسک قطبش نور تغییر می کند. اگر باریکه ای از نور قطبیده روی سطح مغناطیسی بتابد، هنگام بازتاب، نوعاً کمتر از 5° ، تغییر در قطبش نور بازتابیده خواهیم داشت. اگر مغناطش معکوس شود، تغییر در قطبش (زاویه کر) نیز معکوس می شود. این چرخش در گرادیان قطبش، به حالت 0° و 180° مغناطش محیط بستگی دارد.

در فرایند نوشتاری 0° از پرتو لیزر برای گرم کردن حوزه ثبت داده ها تا نزدیک دمای کوری استفاده می شود و برای انتخاب جهت تکانه مغناطیسی در حوزه ثبت، از یک میدان مغناطیسی همان طور که در شکل ۱ (الف) آمده است استفاده می شود.

یک حوزه ثبت (بیت) "۱" یا "۰" به صورت تکانه مغناطیسی بالا (پایین) تعریف می شود.



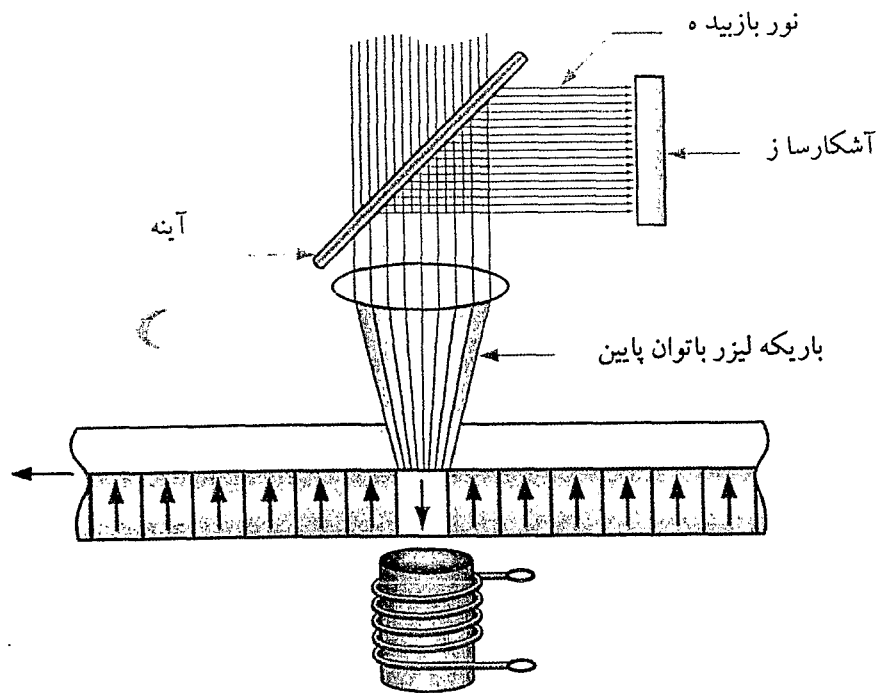
شکل ۱ (الف): طرحی فیزیکی از ثبت داده ها در حوزه مورد نظر

۲-Perpendicular magnetic anisotropy

۴- Perpendicular magneto-optical recording

۵- Writing

فرایند بازخوانی^۱ داده ها، با استفاده از اثر نوری - مغناطیسی کر (PMOKE) صورت می گیرد. یک باریکه لیزر باتوان پایین از ذرات مغناطیسی باقطبیت معکوس شده بازتابیده می شود و قطبش این باریکه تغییر می کند. اگر جهت گیری ذرات معکوس نشود، قطبش باریکه بازتابیده بدون تغییر می ماند. (شکل ۱ب)



شکل ۱(ب): نمایی از فرایند بازخوانی داده ها با استفاده از اثر مغناطیسی نوری کر

۲-۱ آثار نوری - مغناطیسی مواد

۱-۲-۱ اثر فارادی^۲

در سال ۱۸۴۵ مایکل فارادی کشف کرد که هر گاه نور قطبیده از یک قطعه شیشه که در یک میدان مغناطیسی موازی با آن جایگزیده شده عبور نماید، صفحه ارتعاش آن می چرخد. پس از کشف فارادی

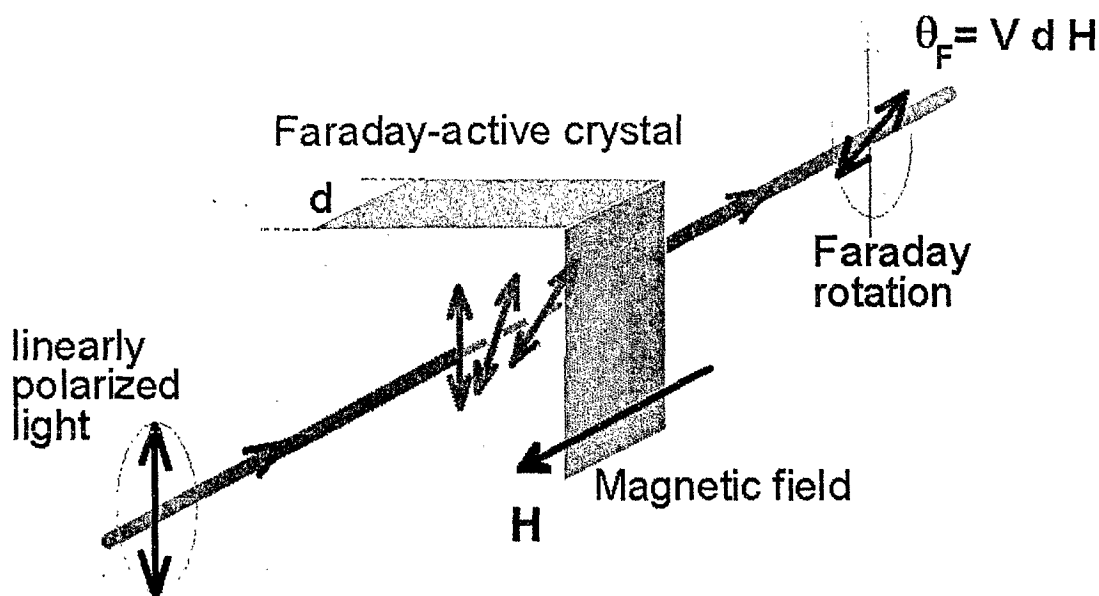
^۱-Reading

^۲-Faraday Effect

این پدیده در بسیاری از جامدات، مایعات و گازها مشاهده شده است. انجام آزمایشات نشان می دهد که میزان چرخش سطح قطبش نور متناسب است با شدت میدان مغناطیسی H و طول محیطی که نور طی می کند. این پدیده در شکل ۲ نشان داده شده است. این چرخش با رابطه زیر نشان داده می شود:

$$\theta = VdH \quad (1)$$

که در آن H شدت میدان با واحد تسلا، d ضخامت با واحد متر، θ زاویه چرخش بر حسب دقیقه و V ثابت وردت که برای هر ماده متفاوت می باشد [۲].



شکل ۲: اثر فارادی در هنگام عبور نور از ماده‌ی مغناطیده شده

برای اجسام فرومغناطیس اندازه ی زاویه چرخش فارادی از رابطه زیر بدست می آید:

$$\theta = KMt \quad (2)$$

که در آن:

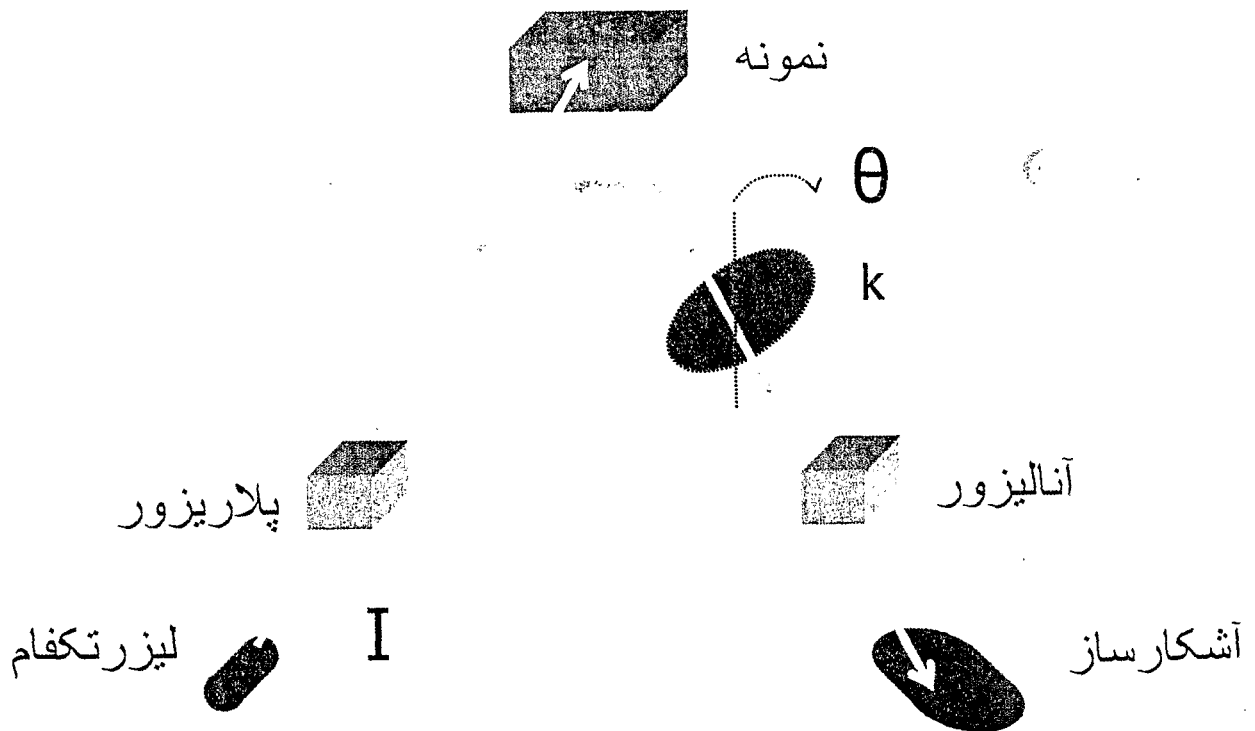
K ثابت کانت^۸ در حدود $350 \text{ degree}/(\text{gauss.cm})$ ، t طول محیط نوری و M مغناطش نمونه

می باشد.

^۸- Kundt constant

۱-۲-۲ اثر کر^۱

اثر کر پدیده ای است که در آن، راستای قطبش نور قطبیده خطی منعکس شده از سطح مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی قوی تغییر می کند که نتیجه آن تبدیل نور قطبیده خطی به قطبیده بیضی است. نور قطبیده حاصل را می توان به دو مد قطبیده دایره ای راستگرد (RCP) و چپگرد (LCP) تجزیه نمود. هر دو اثر کر وفارادی از تفاوت در دو ضریب شکست محیط برای دو مد (LCP) و (RCP) بر می خیزد. به عبارتی چون محیط دارای ضرایب شکست متفاوتی برای دو مد است، این امر سبب می شود که نور قطبیده خطی تبدیل به نور قطبیده بیضوی وار شود.



شکل ۳: تابش نور قطبیده ی خطی به سطح صیقلی، چرخش راستا و نوع قطبش پس از باز تابش

در سطح ماکروسکوپی، از طریق بررسی تانسور دی الکتریک تعمیم یافته، برای یک فرود عمودی می توان نشان داد که زاویه محور اصلی به اندازه زیر می چرخد:

$$\theta_k \equiv \text{Re} \left\{ \frac{n_+ - n_-}{1 - n_+ n_-} \right\} \quad \varepsilon \equiv n^2 \begin{bmatrix} \varepsilon_{XX} & \varepsilon_{XY} & 0 \\ -\varepsilon_{XY} & \varepsilon_{XX} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{ZZ} \end{bmatrix} \quad (3)$$

۱-۲-۳ اثر های کر و فارادی در مواد غیر فرومغناطیس

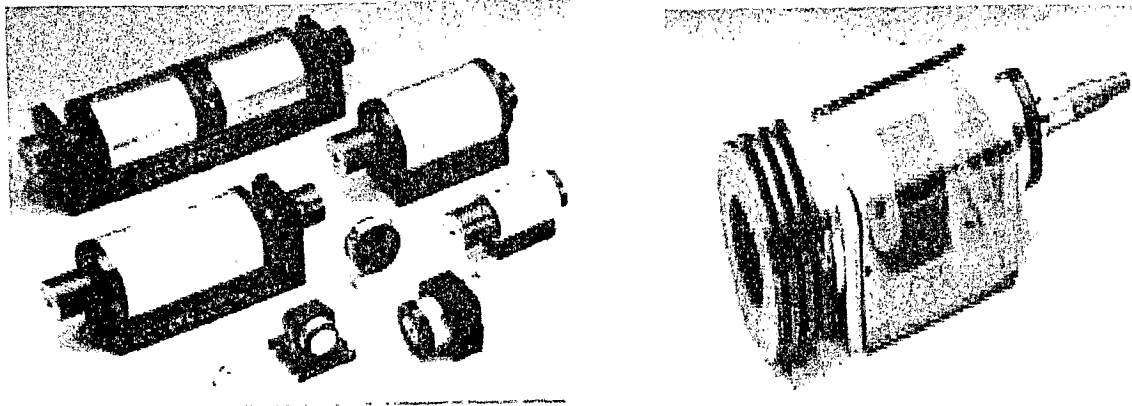
در مواد غیر فرومغناطیس نیز این اثرها با مغناطش خالص نمونه متناسب اند و نه با میدان مغناطیسی خارجی. اختلاف بین فرو مغناطیس ها و غیر فرو مغناطیس ها در مرتبه بزرگی اثرها ست. در نمونه کوارتز چرخش فارادی حدود 2° در هر سانتی متر در حضور میدان $B=10^4$ Gauss می باشد. این در حالی است که در نمونه آهن حدود 380000° در هر سانتی متر، تحت شرایط یکسان می باشد [۳].

۱-۳-۳ کاربردهای اثر مغناطیسی-نوری

۱-۳-۱-۱ مجزاکننده اپتیکی^{۱۰}

این ابزار هانشانگر کاربردی از اثر فارادی می باشند. یک مجزا کننده اپتیکی به نور اجازه عبور در یک جهت می دهد، اما اجازه نمی دهد که در جهت مخالف حرکت کند. مواد MO به طور گسترده ای در مجزا کننده ها به کار می روند. در توان های بالا، فیدبک اپتیکی می تواند عملکرد یک سیستم لیزری را برهم بزند و به آن آسیب رساند. برای کاستن این فیدبک، یک مجزا کننده اپتیکی رامی توان به کاربرد (بر پایه اثر فارادی).

نمونه هایی از مجزا کننده های اپتیکی در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴: مجزا کننده های اپتیکی

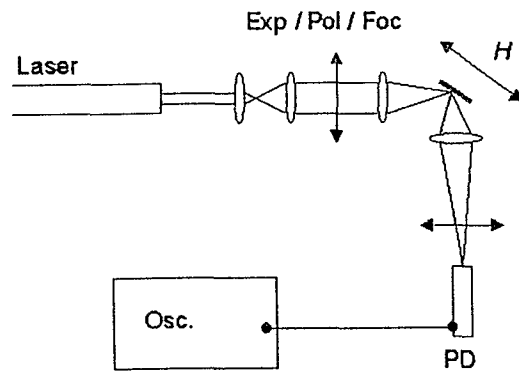
۱-۳-۲ ذخیره سازی نوری-مغناطیسی^{۱۱}

همه مواد مغناطیسی یک دمای مشخصه به نام دمای کوری دارند که بالای این دما به علت بی نظمی کامل حوزه های مغناطیسی، مغناطش شان را از دست می دهند. بنابراین تمامی داده هایی که قبلاً در آنها ذخیره شده از دست می دهند. وادارندگی مغناطیسی ماده، میزانی از مقاومت ماده در برابر مغناطیده شدن توسط میدان مغناطیسی اعمالی می باشد. مهم است که بدانیم وادارندگی مغناطیسی ضمن نزدیک شدن دما به نقطه کوری، کاهش می یابد و با افزایش بیشتر دما به صفر می رسد. برای مواد مغناطیسی جدیدی که در سیستم های MO به کار می روند، این دمای کوری از مرتبه 200°C می باشد. از آنجایی که این سیستم ها قابلیت چندبار پاک شدن دارند، مهم است که بدانیم تغییر در دمای ماده تنها روی مغناطش آن تأثیر می گذارد بدون اینکه ماده تخریب شود.

۱-۳-۳ آشکار سازی مغناطش در اشیاء بسیار کوچک و رسم حلقه پسماند

اثر مغناطیسی-نوری کر، چرخش صفحه قطبش یک نور قطبیده خطی با بازتاب از یک سطح مغناطیسی می باشد. این اثر، ابزاری قدرتمند برای مطالعه دینامیک مغناطش در نمونه های کوچک می باشد.

در این طرح باریکه ای از یک لیزر He-Ne، ابتدا واگرا شده و سپس روی یک لکه کوچک سطح نمونه، همگرا می شود. باریکه بازتابیده شده با یک فتودیود سریع آشکار سازی می شود. سپس درون یک اسیلوسکوپ دیجیتالی سریع خوانده می شود و در نهایت منحنی پسماند رسم می شود.



شکل ۵: نمایی از یک سیستم پسماند رسم کن

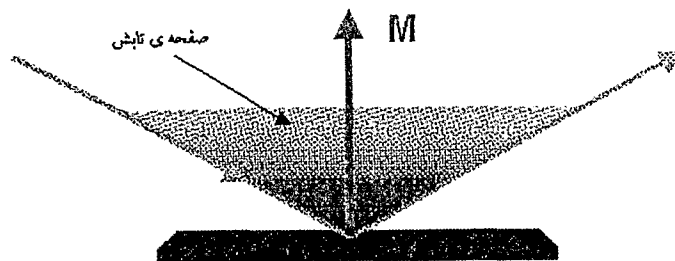
۴-۱ حالات مختلف قطبش و تابش

هریک از دو پدیده را می توان در حالات مختلفی بررسی نمود که عبارتند از [۴]:

۴-۱-۱ حالت قطبی^{۱۲}: در این حالت میدان مغناطیسی خارجی، عمود بر لایه است.

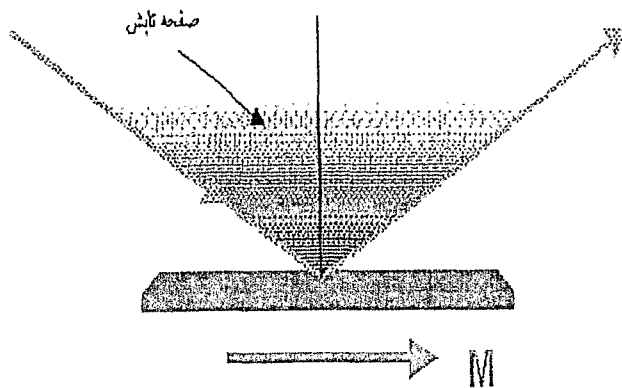
این حالت به شرط آن که نور نیز عمود بر لایه بتابد دارای بیشترین چرخش است (شکل ۶). بر روی

این حالت بیشترین کار تحقیقاتی انجام گرفته است و کاربرد عملی نیز یافته است.



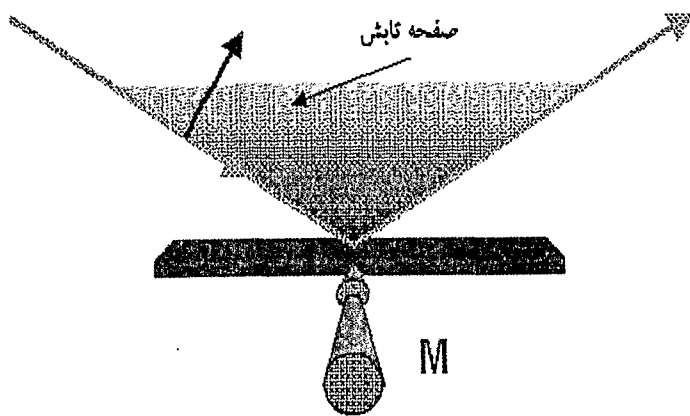
شکل ۶: حالت قطبی

۱-۴-۲ حالت طولی^{۱۳}: در این حالت نور بصورت مایل به سطح لایه می تابد، میدان مغناطیسی خارجی در امتداد صفحه‌ی تابش و بازتابش است (شکل ۷). در تابش عمودی چرخش مشاهده نمی شود.



شکل ۷: حالت طولی

۱-۴-۳ حالت عرضی^{۱۴}: در این حالت نیز نور بصورت مایل به سطح لایه می تابد، میدان مغناطیسی خارجی عمود بر صفحه‌ی تابش و بازتابش است (شکل ۸). در این حالت نیز چرخش برای تابش عمودی وجود ندارد.



شکل ۸: حالت عرضی

۱۳- Longitudinal case

۱۴- Transverse case

۱-۵ تاریخچه تحقیقات

در بیش از یک قرن گذشته، مواد بی شماری به خاطر دارا بودن پتانسیل تکنیکی و کاوش های علمی در خصوصیت شان، به صورت تک لایه، چند لایه ای های نازک بلوری و بی شکل جهت اندازه گیری های مغناطیسی و فراهم نمودن محیطی با چرخش زیاد تهیه شده اند.

یک دسته از این نمونه ها که توجه زیادی را به خود جلب نموده است، آلیاژهای بی شکل خاکهای نادر همراه با فلزات واسطه معروف به RE-TM هستند، عناصر سنگین مانند گادولیم (Gd) و تریوم (Tb) دارای گشتاور مغناطیسی زیاد و دمای کوری کم هستند، با همراهی این عناصر با فلزاتی مانند آهن و کبالت، امکان دستیابی به گشتاور مغناطیسی زیاد در دمای اتاق وجود دارد. حالت بلوری این مواد به علت داشتن جهت های ناهمسانگردی زیاد در هنگام استفاده، اختلال زیادی خواهد داشت.

به بیان دیگر صفر و یک ها در هنگام خواندن از هم تفکیک نشده یا بایکدیگر اشتباه می شوند. اما حالت بی شکل این مواد به شرط رسیدن به مغناطش اشباع، چنین مشکلی ایجاد نمی کند. این ترکیبات در حال حاضر با داشتن چرخش چند درجه ای، به صورت تجاری برای ثبت و خواندن اطلاعات به روش نوری-مغناطیسی کاربرد دارند.

ترکیبات مهم دیگری که از اهمیت و توجه خاصی برخوردارند، ترکیبات بر پایه منگنز می باشد. یکی از این ترکیبات Mn/Sb می باشد. در پروژه ای که در سال ۲۰۰۰ با همکاری دو دانشگاه چینی و ملی سنگاپور اجرا شد Mn/Sb بر روی زیر لایه ی یاقوت که دارای ساختار مشابه با ساختار Mn/Sb است، رشد داده شد. اندازه گیری ها نشان دهنده ی چرخش ۰/۵ درجه در اثر کر بود [۵].

در تحقیقی که توسط رویندران، دلین، جیمز و جانسون در دانشگاه آپسالای سوئد انجام شده است، بر روی پایه ی Mn کار شده است. در این تحقیق اثر کر برای Mn/As و Mn/Sb و Mn/Bi مورد بررسی قرار گرفته اند. در نمونه Mn/As کمترین چرخش دیده شده است. در Mn/Sb و Mn/Bi مقدار چرخش به ترتیب ۱/۱ و ۱/۶ درجه است [۶].

از دیگر ترکیبات مهم در این زمینه، ترکیبات منگنز و کبالت به صورت چند لایه ای و ترکیب با تناسب عنصری و فرمول شیمیایی خاص می باشد که مربوط به کار می باشد.

۶-۱ منابع

- [۱]- J.Ferre."New Magneto Optical Recording Media".Laboratoire de Physique des solides,UMR CNRS ۸۵۰۲,Bat ۵۱۰.Universite Paris-sud,۹۱۴۰۵,Orsay,France.
- [۲]-Jason D.Darfus."The Faraday Effect" Physics Department, The College of Wooster, Wooster, Ohio ۴۴۶۹۱,may ۱۹۹۷.
- [۳]- Petros N. Argyres, " Theory of the Faraday and Kerr in Ferromagnetics" Department of Physics, University of California, Berkeley, ۱۹۷۸ .
- [۴]- Measurement of Magnetic Properties of Thin Films By Homan Bernard Yuen B. A. (University of California at Berkeley) ۲۰۰۰.
- [۵]- H. Meng, H. S. Lim, C. K. Ong, Y. P. Feng, Z. Yang. "Magnetic and Magneto-Optical Property of MnSb Films Grown on Sapphire Substrate", ۲۰۰۰.
- [۶]- P.Ravindran, A. Delin, P. James, and B. Johansson, "Magnetic, optical, and magneto-optical properties of MnX(As, Sb, or Bi) from full-potential calculations", *Uppsala University, Sweden*, ۱۹۹۹.

فصل دوم

مبانی نظری

رفتار نوری - مغناطیسی

۱-۲ پیشگفتار

۲-۲ نظریه‌ی کلاسیک رفتار نوری - مغناطیسی

۳-۲ نظریه‌ی کوانتومی رفتار نوری - مغناطیسی

۴-۲ منابع

۱-۲ پیشگفتار

وقتی نور وارد محیط رسانا می شود، میدانهای الکتریکی و مغناطیسی نور بر الکترونها اثر می گذارند و الکترون نیز که خود تحت تأثیر پتانسیل هسته ها و شبکه قرار دارد می تواند بر نور تأثیر متقابل داشته باشد.

بر اساس قوانین ماکسول:

$$\text{rot } \vec{H} = \dot{\vec{D}} + \vec{j}$$

$$\text{rot } \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

$$\text{div } \vec{D} = \rho$$

که برای مواد رسانا، مقدار ρ برابر صفر است. مقادیر B, M, H, D, E طبق روابط زیر به یکدیگر مربوطند،

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

که P قطبیدگی الکتریکی و M مغناطیدگی و D جابجائی الکتریکی است. برای میدانهای کوچک، J, P, E و M به H به طور خطی وابسته اند، که این وابستگی به صورت زیر است.